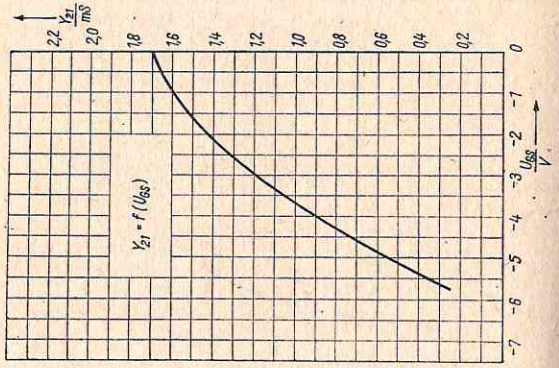
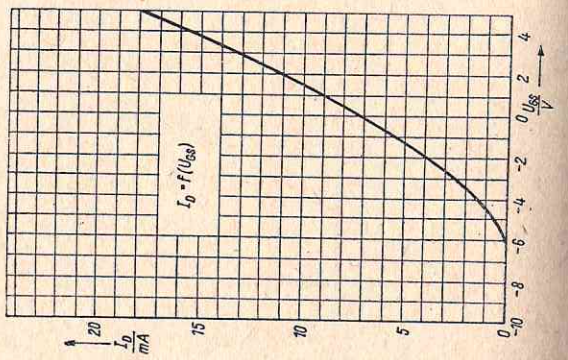
RFT electronic

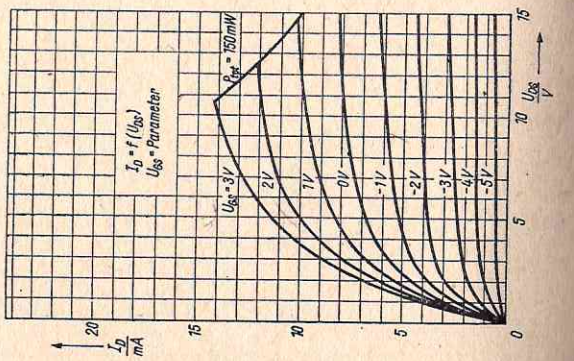
Steilheit bei $U_{DS} = 8$ V



Eingangskennlinie bei $U_{DS} = 8$ V

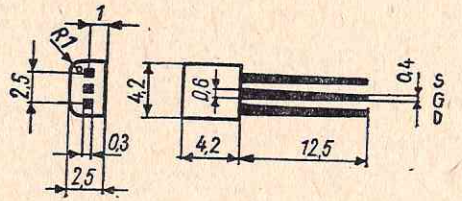


Ausgangskennlinien



RFT electronic

Silizium-MOS-Feldeffekt-Transistor (n-Kanal-Depletion-Typ) mit hoher Eingangsimpedanz für allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200—8380. Das Substrat ist innerhalb des Gehäuses mit Source verbunden.



Masse ca. 0,3 g

Wärmewiderstand $R_{thch/a} \leqq 0{,}6$ grd/mW

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Drain-Source-Spannung	U_{DSV}	= 20 V
Gate-Source-Spannung	U_{GS}	= −15 V bis +5 V
Drain-Gate-Spannung	U_{DG}	= 30 V
Drainstrom	I_D	= 15 mA
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta a = 25$ °C	P_{tot}	= 150 mW
Kanaltemperatur	ϑ_{Ch}	= +125 °C
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	= 0 °C bis +125 °C